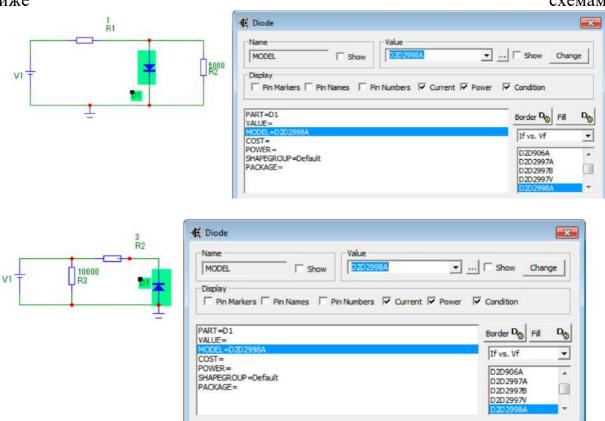
## Дисциплина основы электроники

## Лабораторный практикум №1 по теме «Полупроводниковые диоды»

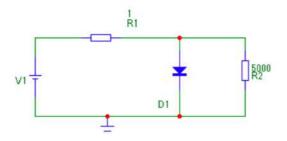
Работу выполнила: студентка группы ИУ7-31Б Варламова Екатерина **Цель работы:** получение в программе схемотехнического анализа Micro-сар 10.0.9.2 и исследование статических и динамических характеристик германиевого или кремниевого полупроводниковых диодов с целью определения по ним параметров модели полупроводниковых диодов. Освоение программы Mathcad для расчёта параметров модели полупроводниковых приборов на основе данных экспериментальных исследований и внесение модели в базу данных программ схемотехнического анализа.

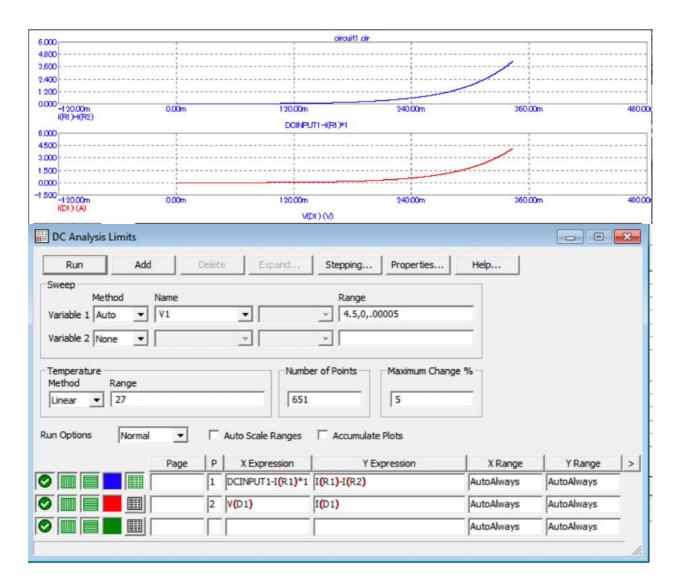
Для заданного диода марки D2d2998a, соответствующий моему варианту, проведем моделирование лабораторного стенда для получения BAX диода в программе Micro-Cap 9 как на прямой, так и на обратной ветвях по показанным ниже схемам:



Данный выбор схем объясняется следующими соображениями. Несмотря на то, что идеальных измерительных приборов не существует, все- таки амперметр должен обладать относительно малым сопротивлением, а вольтметр, наоборот, довольно значительным. При прямом включении диод имеет малое сопротивление, и, если параллельно к нему подключить вольтметр, то потери в токе будут не значительны, т.к. сопротивление вольтметра во много раз превышает сопротивление диода при прямом включении. При обратном включении такая схема не прокатит, т.к. сопротивления диода и вольтметра станут соизмеримы, и потери в токе окажутся весомыми. Поэтому следует точно измерить ток на ветви диода, вставив в нее амперметр, потерями напряжения можно пренебречь, т.к. падение напряжения на диоде при обратном включении будет гораздо больше потерь на амперметре. Проиллюстрируем сказанное графиками, построенным в Місго-Сар 9 по схемам, приведенным выше.

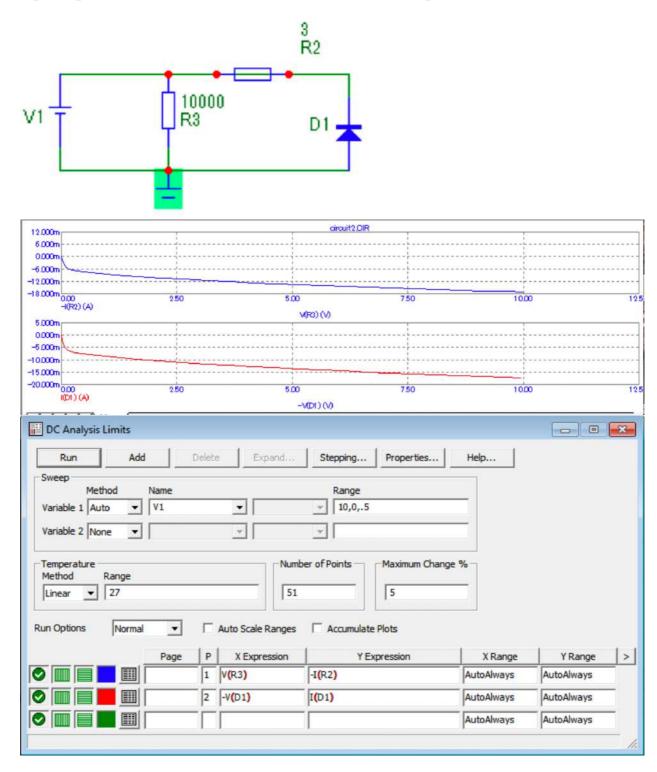
При прямом включении диода его ВАХ выглядит следующим образом:





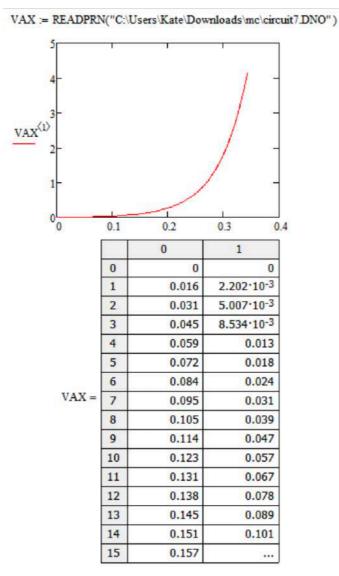
При этом «синий» график показывает BAX при снятии измерений с приборов (то есть амперметра и вольтметра), а «красный» при снятии измерений с диода.

При обратном включении ВАХ выглядит таким образом:



При этом «синий» график показывает BAX при снятии измерений с приборов (то есть амперметра и вольтметра), а «красный» при снятии измерений с диода.

Как хорошо видно из графиков, наши догадки оказались верны, и ВАХ, снятые по показаниям «приборов», ненамного отличаются от своих истинных значений. Поэтому, для чистоты эксперимента, сохраним в текстовом файле и будем использовать в дальнейшем данные, снятые по показаниям «приборов».



Для анализа нашей BAX и нахождения физических параметров диода воспользуемся программой MathCAD. Чтобы вычислительный блок Given...Міпетт сработал как можно точнее, возьмем 4 точки в наиболее нелинейной части BAX.

$$Id1 := \max(VAX^{\langle 1 \rangle}) = 4.156 \qquad Ud1 := \max(VAX^{\langle 0 \rangle}) = 0.344$$

$$Id2 := \frac{Id1}{2.374} = 1.751 \qquad Ud2 := \operatorname{linterp}(VAX^{\langle 1 \rangle}, VAX^{\langle 0 \rangle}, Id2) = 0.299$$

$$Id3 := \frac{Id2}{2} = 0.875 \qquad Ud3 := \operatorname{linterp}(VAX^{\langle 1 \rangle}, VAX^{\langle 0 \rangle}, Id3) = 0.263$$

$$Id4 := \frac{Id3}{2} = 0.438 \qquad Ud4 := \operatorname{linterp}(VAX^{\langle 1 \rangle}, VAX^{\langle 0 \rangle}, Id4) = 0.227$$

Вычисление параметров диода методом по 3 точкам:

$$\frac{\text{Rb}}{\text{Id3}} := \frac{(\text{Ud3} - 2 \cdot \text{Ud2} + \text{Ud1})}{\text{Id3}} = 0.011$$

$$\frac{\text{NfT}}{\text{In}} := \frac{[(3 \cdot \text{Ud2} - 2 \cdot \text{Ud3}) - \text{Ud1}]}{\text{In}(2)} = 0.038$$

$$\frac{\left[(\text{Ud2} - 2 \cdot \text{Ud3})\right]}{\text{NfT}} = 2.189 \times 10^{-3}$$

Вычисление параметров диода методом по 4 точкам:

$$m := 0.5$$
 Rb := 0.0000003 NfT := 0.02 Iso := 0.0000001

Given

$$Ud1 = Id1 \cdot Rb + ln \left[ \frac{(Iso + Id1)}{Iso} \right] \cdot NfT \cdot m$$

$$Ud2 = Id2 \cdot Rb + ln \left[ \frac{(Iso + Id2)}{Iso} \right] \cdot NfT \cdot m$$

$$Ud3 = Id3 \cdot Rb + ln \left[ \frac{(Iso + Id3)}{Iso} \right] \cdot NfT \cdot m$$

$$Ud4 = Id4 \cdot Rb + ln \left[ \frac{(Iso + Id4)}{Iso} \right] \cdot NfT \cdot m$$

Diod\_P := Minerr(Iso, Rb, NfT, m)

$$Diod_P = \begin{pmatrix} 5.644 \times 10^{-3} \\ 2.392 \times 10^{-6} \\ 0.048 \\ 1.094 \end{pmatrix}$$

Построим на одном графике ВАХ экспериментальную и ВАХ модельную (параметры диода рассчитаны методом по 3 точкам):

$$Idiod := 0, 10^{-5} ... 4.156 \qquad Udiod(Idiod) := Idiod \cdot Rb + NfT \cdot In \left[ \frac{(Iso + Idiod)}{Iso} \right]$$

